

半導体材料として、SiC は Si に対して3倍のバンドギャップ、10倍の絶縁破壊電界強度、3倍の熱伝導率を有します。Si と比べて高耐圧化や低抵抗化、低損失化、高温動作化の点で優れているため、パワーデバイス用途として期待されています。当社でもSiCデバイス開発に着手しており、2018年からの量産を目指しております。同時に、化合物ラインのファクトリー（OEM）も進めており、ワイドバンドギャップ半導体（SiC、FaN、GaAs、Ga2O3、ダイヤモンド、etc. . . ）の未来に貢献します。

PHENITEC
Phenitec...fast and focused!

SiC Devices

PHENITEC
SEMICONDUCTOR Corp.

2017
2018
2019
2020
2021

S_{BD} 600V/10A~

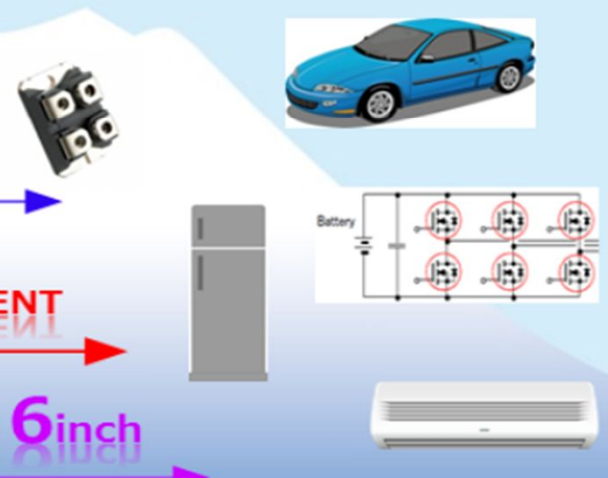
→ Mass production →


S_{BD} 1200V/10A~

→ Mass production →

MOSFET DEVICE DEVELOPMENT

Foundry Process for 4inch and 6inch





SiC of PHENITEC is made in JAPAN.

2017
2018
2019
2020
2021

Phenitec...Fast and focused !
<http://phenitec.co.jp/>